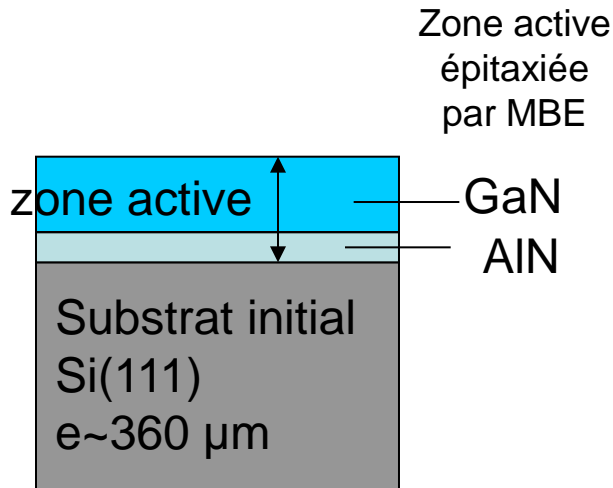
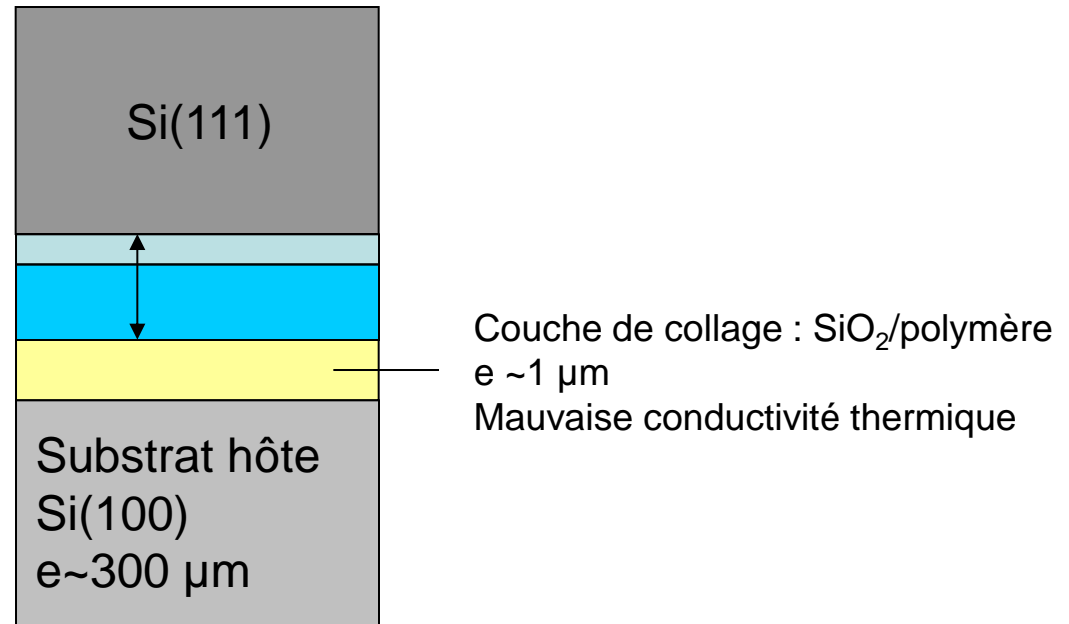


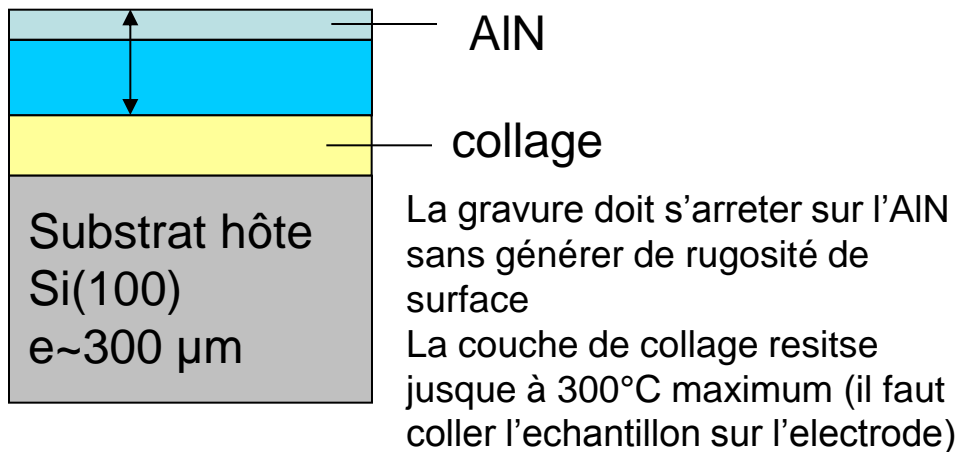
1. Structure initiale



2. Report sur substrat hôte



3. Retrait du substrat Si(111)



4. Litho électronique, gravure sèche pour mise en forme de l'AlN/GaN, puis **sous-gravure** de la couche de collage (la partie SiO_2 sous le GaN) pour générer une structure suspendue (LPN).

Objectif : membrane opto-mécanique avec résonance optique vers $\lambda = 1.5 \mu\text{m}$